



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	张应力 LPCVD SiO ₂ 膜的制造方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201110448748.4
申请日期:	2011-12-28
专利号:	201110448748.4
第一发明人:	尚海平;焦斌斌;刘瑞文;陈大鹏;李志刚;卢狄克
实施情况:	授权
专利证书号:	201110448748.4
其它备注:	先导中心

